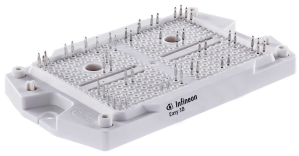
EasyPIM™ Modul mit TRENCHSTOP™ IGBT7 und Emitter Controlled 7 Diode und PressFIT / NTC



Eigenschaften

- Elektrische Eigenschaften
  - V_{CES} = 1200 V
  - $I_{C\ nom}$ = 50 A / I_{CRM} = 100 A
  - Trenchstop™ IGBT7
  - Überlastbetrieb bis zu 175°C
  - Niedriges V_{CEsat}
- Mechanische Eigenschaften
  - PressFIT Verbindungstechnik
  - Hohe Leistungsdichte
  - Gehäuse mit CTI > 400
  - Kompaktes Design
  - Al_2O_3 Substrat mit kleinem thermischen Widerstand
  - 2,5 kV AC 1min Isolationsfestigkeit

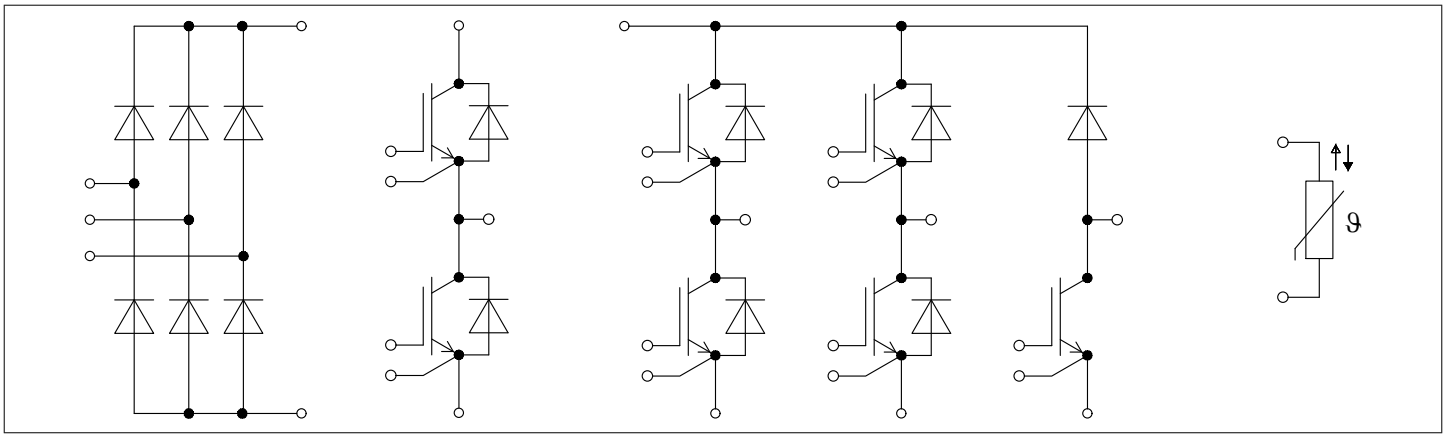
Potenzielle Anwendungen

- Motorantriebe
- Klimaanlagen
- Hilfsumrichter

Produktvalidierung

- Qualifiziert für Industrieanwendungen entsprechend den relevanten Tests der IEC 60747, 60749 und 60068

Beschreibung



Inhalt

	Beschreibung	1
	Eigenschaften	1
	Potenzielle Anwendungen	1
	Produktvalidierung	1
	Inhalt	2
1	**Gehäuse**	3
2	**IGBT, Wechselrichter**	3
3	**Diode, Wechselrichter**	5
4	**Diode, Gleichrichter**	6
5	**IGBT, Brems-Chopper**	7
6	**Diode, Brems-Chopper**	8
7	**NTC-Widerstand**	9
8	**Kennlinien**	10
9	**Schaltplan**	16
10	**Gehäuseabmessungen**	16
11	**Modul-Label-Code**	17
	Änderungshistorie	18
	Disclaimer	19

1 Gehäuse

Tabelle 1 Isolationskoordination

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Isolations-Prüfspannung	V_{ISOL}	RMS, f = 50 Hz, *t* = 1 min	2.5	kV
Innere Isolation		Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140)	Al_2O_3	
Kriechstrecke	d_{Creep}	Kontakt - Kühlkörper	11.2	mm
Kriechstrecke	d_{Creep}	Kontakt - Kontakt	6.8	mm
Luftstrecke	d_{Clear}	Kontakt - Kühlkörper	9.4	mm
Luftstrecke	d_{Clear}	Kontakt - Kontakt	5.5	mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	*CTI*		> 400	
Relativer Temperaturindex (elektr.)	*RTI*	Gehäuse	140	°C

Tabelle 2 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Modulstreuinduktivität	L_{sCE}				35		nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip	$R_{AA'+CC'}$	T_H = 25 °C, pro Schalter			2.8		mΩ
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip	$R_{CC'+EE'}$	T_H = 25 °C, pro Schalter			2.2		mΩ
Lagertemperatur	T_{stg}			-40		125	°C
Anzugsdrehmoment f. Modulmontage	*M*	- Montage gem. gültiger Applikationsschrift	M5, Schraube	1.3		1.5	Nm
Gewicht	*G*				78		g

Anmerkung: The current under continuous operation is limited to 25 A rms per connector pin.

2 IGBT, Wechselrichter

Tabelle 3 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Kollektor-Emitter-Sperrspannung	V_{CES}		T_{vj} = 25 °C	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom	I_{CDC}	$T_{vj\,max}$ = 175 °C	T_H = 100 °C	50	A
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom	I_{CRM}	t_p begrenzt durch $T_{vj\,op}$		100	A

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 3 (Fortsetzung) Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Gate-Emitter-Spitzenspannung	V_{GES}		±20	V

Tabelle 4 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung	$V_{CE\ sat}$	I_C = 50 A, V_{GE} = 15 V	T_{vj} = 25 °C		1.50	1.80	V
			T_{vj} = 125 °C		1.64		
			T_{vj} = 175 °C		1.72		
Gate-Schwellenspannung	V_{GEth}	I_C = 1.28 mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25 °C		5.15	5.80	6.45	V
Gateladung	Q_G	V_{GE} = ±15 V, V_{CC} = 600 V			0.92		µC
Interner Gatewiderstand	R_{Gint}	T_{vj} = 25 °C			0		Ω
Eingangskapazität	C_{ies}	f = 100 kHz, T_{vj} = 25 °C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V			11.1		nF
Rückwirkungskapazität	C_{res}	f = 100 kHz, T_{vj} = 25 °C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V			0.039		nF
Kollektor-Emitter-Reststrom	I_{CES}	V_{CE} = 1200 V, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25 °C			0.013	mA
Gate-Emitter-Reststrom	I_{GES}	V_{CE} = 0 V, V_{GE} = 20 V, T_{vj} = 25 °C				100	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{don}	I_C = 50 A, V_{CC} = 600 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 5.1 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.044		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.046		
			T_{vj} = 175 °C		0.047		
Anstiegszeit (induktive Last)	t_r	I_C = 50 A, V_{CC} = 600 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 5.1 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.031		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.036		
			T_{vj} = 175 °C		0.037		
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{doff}	I_C = 50 A, V_{CC} = 600 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 5.1 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.237		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.321		
			T_{vj} = 175 °C		0.354		
Fallzeit (induktive Last)	t_f	I_C = 50 A, V_{CC} = 600 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 5.1 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.122		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.191		
			T_{vj} = 175 °C		0.256		
Einschaltverlustenergie pro Puls	E_{on}	I_C = 50 A, V_{CC} = 600 V, L_σ = 35 nH, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 5.1 Ω, di/dt = 1180 A/µs (T_{vj} = 175 °C)	T_{vj} = 25 °C		4.18		mJ
			T_{vj} = 125 °C		5.62		
			T_{vj} = 175 °C		6.55		
Abschaltverlustenergie pro Puls	E_{off}	I_C = 50 A, V_{CC} = 600 V, L_σ = 35 nH, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 5.1 Ω, dv/dt = 2900 V/µs (T_{vj} = 175 °C)	T_{vj} = 25 °C		3.1		mJ
			T_{vj} = 125 °C		5.08		
			T_{vj} = 175 °C		6.22		

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 4 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Kurzschlussverhalten	I_{SC}	$V_{GE} \le 15$ V, $V_{CC} = 800$ V, $V_{CEmax}=V_{CES}-L_{sCE}*di/dt$	$t_P \le 8$ µs, $T_{vj}=150$ °C		185		A
			$t_P \le 7$ µs, $T_{vj}=175$ °C		175		
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro IGBT, $\lambda_{grease} = 3.3$ W/(m·K)			0.708		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\,op}$			-40		175	°C

Anmerkung: Tvj op > 150°C is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN 2018-14.

3 Diode, Wechselrichter

Tabelle 5 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}		$T_{vj} = 25$ °C	1200	V
Dauergleichstrom	I_F			50	A
Periodischer Spitzenstrom	I_{FRM}	$t_P = 1$ ms		100	A
Grenzlastintegral	I^2t	$t_P = 10$ ms, $V_R = 0$ V	$T_{vj} = 125$ °C	300	A^2s
			$T_{vj} = 175$ °C	250	

Tabelle 6 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Durchlassspannung	V_F	$I_F = 50$ A, $V_{GE} = 0$ V	$T_{vj} = 25$ °C		1.72	2.10	V
			$T_{vj} = 125$ °C		1.59		
			$T_{vj} = 175$ °C		1.52		
Rückstromspitze	I_{RM}	$V_{CC} = 600$ V, $I_F = 50$ A, $V_{GE} = -15$ V, $-di_F/dt =$ 1180 A/µs ($T_{vj} = 175$ °C)	$T_{vj} = 25$ °C		49.7		A
			$T_{vj} = 125$ °C		64.5		
			$T_{vj} = 175$ °C		74.9		
Sperrverzögerungsladung	Q_r	$V_{CC} = 600$ V, $I_F = 50$ A, $V_{GE} = -15$ V, $-di_F/dt =$ 1180 A/µs ($T_{vj} = 175$ °C)	$T_{vj} = 25$ °C		4.49		µC
			$T_{vj} = 125$ °C		7.76		
			$T_{vj} = 175$ °C		10.2		

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 6 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Abschaltenergie pro Puls	E_{rec}	V_{CC} = 600 V, I_F = 50 A, V_{GE} = -15 V, -di$_F$/dt = 1180 A/µs (T_{vj} = 175 °C)	T_{vj} = 25 °C		1.75		mJ
			T_{vj} = 125 °C		3.08		
			T_{vj} = 175 °C		4.01		
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro Diode, λ_{grease} = 3.3 W/(m·K)			0.963		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\,op}$			-40		175	°C

Anmerkung: Tvj op > 150°C is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN 2018-14.

4 Diode, Gleichrichter

Tabelle 7 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}		T_{vj} = 25 °C	1600	V
Durchlassstrom Grenzeffektivwert pro Chip	I_{FRMSM}	T_H = 80 °C		60	A
Gleichrichter Ausgang Grenzeffektivstrom	I_{RMSM}	T_H = 80 °C		100	A
Stoßstrom Grenzwert	I_{FSM}	t_P = 10 ms	T_{vj} = 25 °C	450	A
			T_{vj} = 150 °C	370	
Grenzlastintegral	I^2t	t_P = 10 ms	T_{vj} = 25 °C	1010	A^2s
			T_{vj} = 150 °C	685	

Tabelle 8 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Durchlassspannung	V_F	I_F = 35 A	T_{vj} = 150 °C		1.04		V
Sperrstrom	I_r	T_{vj} = 150 °C, V_R = 1600 V			1		mA
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro Diode, λ_{grease} = 3.3 W/(m·K)			1.06		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj,\,op}$			-40		150	°C

5 IGBT, Brems-Chopper

Tabelle 9 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Kollektor-Emitter-Sperrspannung	V_{CES}		T_{vj} = 25 °C	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom	I_{CDC}	$T_{vj\,max}$ = 175 °C	T_H = 100 °C	35	A
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom	I_{CRM}	t_p begrenzt durch $T_{vj\,op}$		70	A
Gate-Emitter-Spitzenspannung	V_{GES}			±20	V

Tabelle 10 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung	$V_{CE\,sat}$	I_C = 35 A, V_{GE} = 15 V	T_{vj} = 25 °C		1.60	1.85	V
			T_{vj} = 125 °C		1.74		
			T_{vj} = 175 °C		1.82		
Gate-Schwellenspannung	V_{GEth}	I_C = 0.75 mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25 °C		5.15	5.80	6.45	V
Gateladung	Q_G	V_{GE} = ±15 V, V_{CC} = 600 V			0.548		µC
Interner Gatewiderstand	R_{Gint}	T_{vj} = 25 °C			0		Ω
Eingangskapazität	C_{ies}	f = 100 kHz, T_{vj} = 25 °C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V			6.62		nF
Rückwirkungskapazität	C_{res}	f = 100 kHz, T_{vj} = 25 °C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V			0.023		nF
Kollektor-Emitter-Reststrom	I_{CES}	V_{CE} = 1200 V, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25 °C			0.0091	mA
Gate-Emitter-Reststrom	I_{GES}	V_{CE} = 0 V, V_{GE} = 20 V, T_{vj} = 25 °C				100	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{don}	I_C = 35 A, V_{CC} = 600 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 5.1 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.041		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.043		
			T_{vj} = 175 °C		0.044		
Anstiegszeit (induktive Last)	t_r	I_C = 35 A, V_{CC} = 600 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 5.1 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.038		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.040		
			T_{vj} = 175 °C		0.041		
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{doff}	I_C = 35 A, V_{CC} = 600 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 5.1 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.219		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.274		
			T_{vj} = 175 °C		0.321		
Fallzeit (induktive Last)	t_f	I_C = 35 A, V_{CC} = 600 V, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 5.1 Ω	T_{vj} = 25 °C		0.077		µs
			T_{vj} = 125 °C		0.132		
			T_{vj} = 175 °C		0.181		

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 10 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Einschaltverlustenergie pro Puls	E_{on}	I_C = 35 A, V_{CC} = 600 V, L_σ = 35 nH, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 5.1 Ω, di/dt = 790 A/µs (T_{vj} = 175 °C)	T_{vj} = 25 °C		1.92		mJ
			T_{vj} = 125 °C		2.85		
			T_{vj} = 175 °C		3.43		
Abschaltverlustenergie pro Puls	E_{off}	I_C = 35 A, V_{CC} = 600 V, L_σ = 35 nH, V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 5.1 Ω, dv/dt = 2500 V/µs (T_{vj} = 175 °C)	T_{vj} = 25 °C		2.28		mJ
			T_{vj} = 125 °C		3.29		
			T_{vj} = 175 °C		4.25		
Kurzschlussverhalten	I_{SC}	V_{GE} ≤ 15 V, V_{CC} = 800 V, V_{CEmax}=V_{CES}-L_{sCE}*di/dt	t_P ≤ 8 µs, T_{vj}=150 °C		110		A
			t_P ≤ 7 µs, T_{vj}=175 °C		100		
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro IGBT, λ_{grease} = 3.3 W/(m·K)			0.995		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\,op}$			-40		175	°C

Anmerkung: Tvj op > 150°C is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN 2018-14.

6 Diode, Brems-Chopper

Tabelle 11 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}		T_{vj} = 25 °C	1200	V
Dauergleichstrom	I_F			25	A
Periodischer Spitzenstrom	I_{FRM}	t_P = 1 ms		50	A
Grenzlastintegral	I^2t	t_P = 10 ms, V_R = 0 V	T_{vj} = 125 °C	72.5	A^2s
			T_{vj} = 175 °C	63	

Tabelle 12 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Durchlassspannung	V_F	I_F = 25 A, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25 °C		1.83	2.30	V
			T_{vj} = 125 °C		1.70		
			T_{vj} = 175 °C		1.63		

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 12 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Rückstromspitze	I_{RM}	V_{CC} = 600 V, I_F = 25 A, -di$_F$/dt = 580 A/µs (T_{vj} = 175 °C)	T_{vj} = 25 °C		36.1		A
			T_{vj} = 125 °C		49		
			T_{vj} = 175 °C		55.5		
Sperrverzögerungsladung	Q_r	V_{CC} = 600 V, I_F = 25 A, -di$_F$/dt = 580 A/µs (T_{vj} = 175 °C)	T_{vj} = 25 °C		2.93		µC
			T_{vj} = 125 °C		4.44		
			T_{vj} = 175 °C		6.5		
Abschaltenergie pro Puls	E_{rec}	V_{CC} = 600 V, I_F = 25 A, -di$_F$/dt = 580 A/µs (T_{vj} = 175 °C)	T_{vj} = 25 °C		0.69		mJ
			T_{vj} = 125 °C		1.76		
			T_{vj} = 175 °C		2.84		
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro Diode, λ_{grease} = 3.3 W/(m·K)			1.86		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\,op}$			-40		175	°C

Anmerkung: Tvj op > 150°C is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN 2018-14.

7 NTC-Widerstand

Tabelle 13 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Nennwiderstand	R_{25}	T_{NTC} = 25 °C		5		kΩ
Abweichung von R_{100}	$\Delta R/R$	T_{NTC} = 100 °C, R_{100} = 493 Ω	-5		5	%
Verlustleistung	P_{25}	T_{NTC} = 25 °C			20	mW
B-Wert	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2\text{-}1/(298{,}15\ K))]$		3375		K
B-Wert	$B_{25/80}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2\text{-}1/(298{,}15\ K))]$		3411		K
B-Wert	$B_{25/100}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2\text{-}1/(298{,}15\ K))]$		3433		K

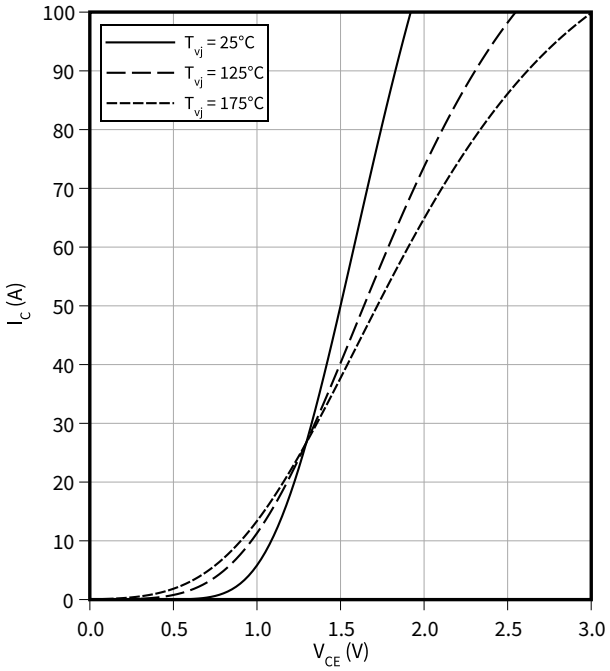
Anmerkung: Angaben gemäß gültiger Application Note.

8 Kennlinien

Ausgangskennlinie (typisch), IGBT, Wechselrichter

$I_C = f(V_{CE})$

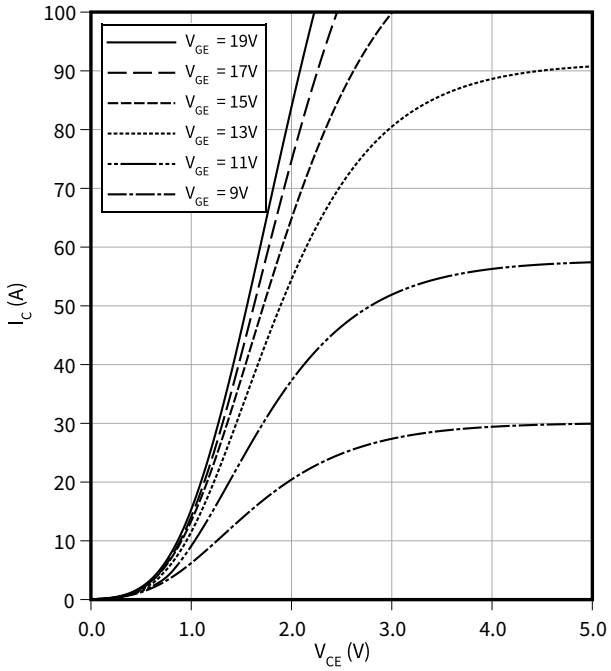
V_{GE} = 15 V



Ausgangskennlinienfeld (typisch), IGBT, Wechselrichter

$I_C = f(V_{CE})$

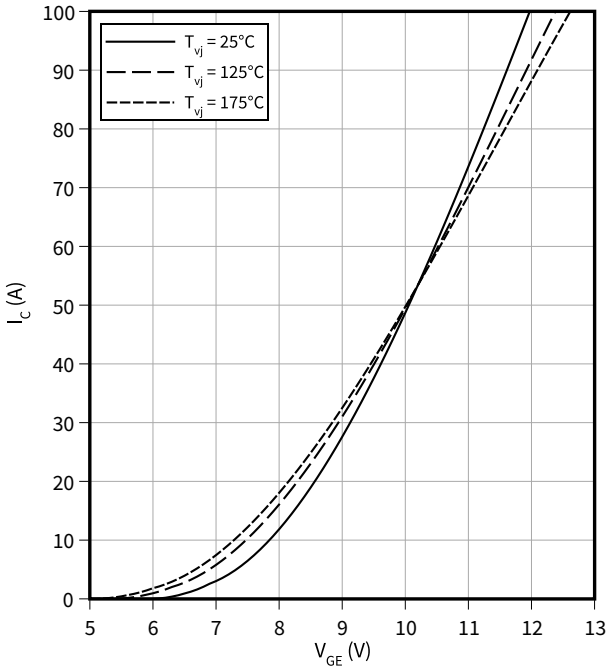
T_{vj} = 175 °C



Übertragungscharakteristik (typisch), IGBT, Wechselrichter

$I_C = f(V_{GE})$

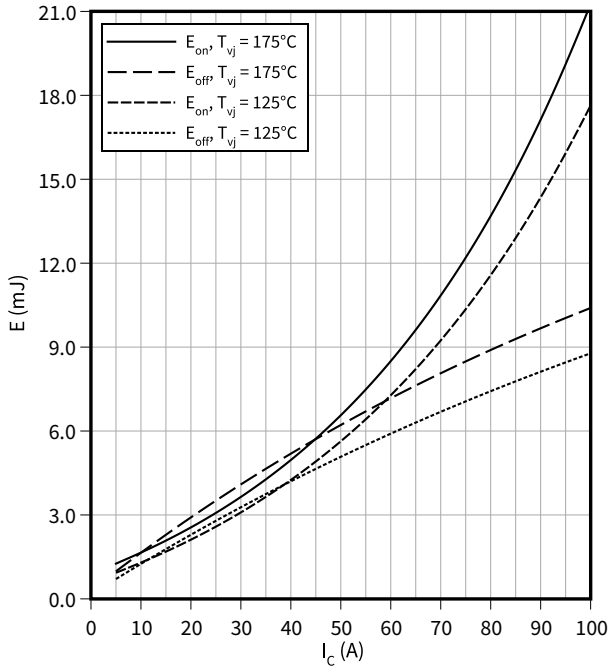
V_{CE} = 20 V



Schaltverluste (typisch), IGBT, Wechselrichter

$E = f(I_C)$

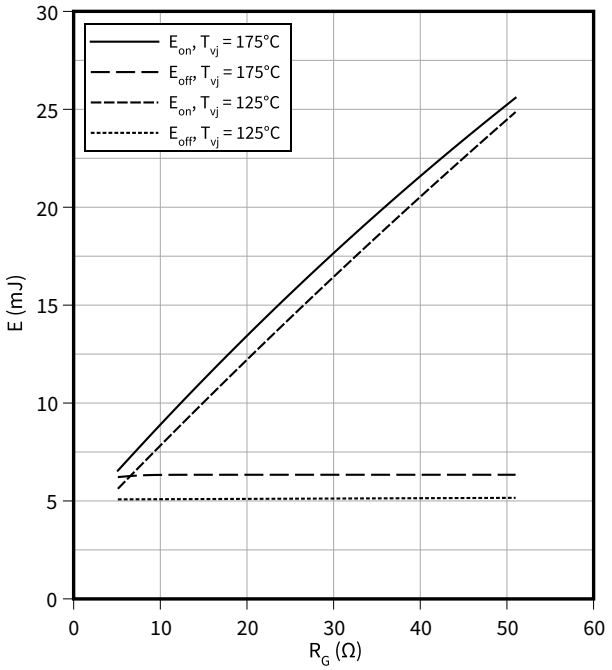
R_{Goff} = 5.1 Ω, R_{Gon} = 5.1 Ω, V_{GE} = ±15 V, V_{CC} = 600 V



Schaltverluste (typisch), IGBT, Wechselrichter

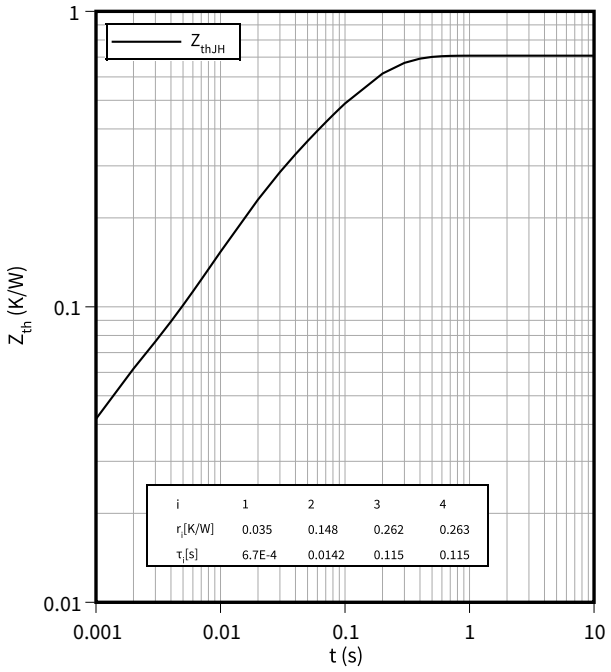
$E = f(R_G)$

$V_{GE} = \pm 15$ V, $I_C = 50$ A, $V_{CC} = 600$ V



Transienter Wärmewiderstand , IGBT, Wechselrichter

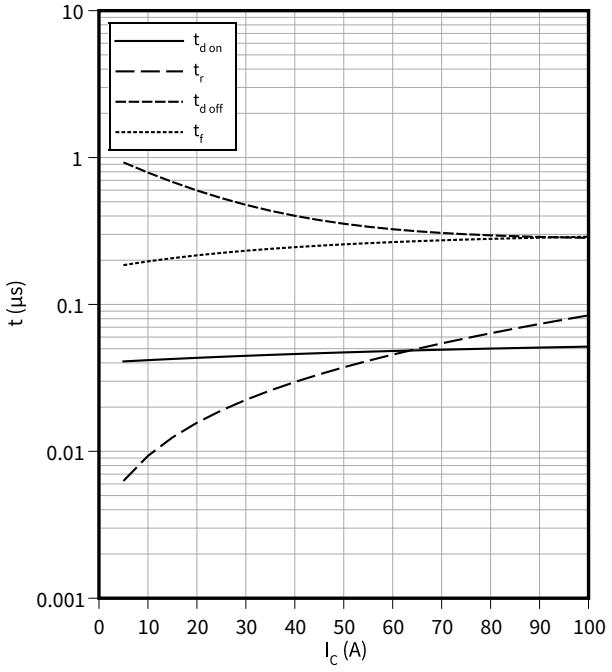
$Z_{th} = f(t)$



Schaltzeiten (typisch), IGBT, Wechselrichter

$t = f(I_C)$

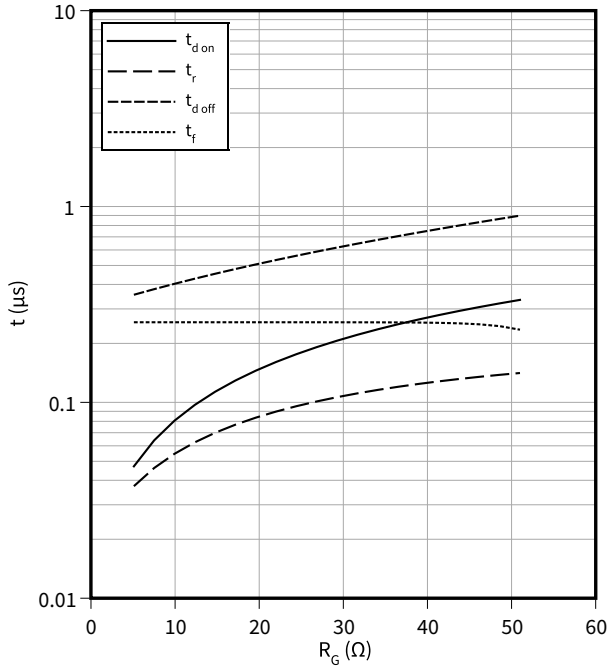
$R_{Goff} = 5.1\ \Omega$, $R_{Gon} = 5.1\ \Omega$, $V_{GE} = \pm 15$ V, $V_{CC} = 600$ V, $T_{vj} = 175$ °C



Schaltzeiten (typisch), IGBT, Wechselrichter

$t = f(R_G)$

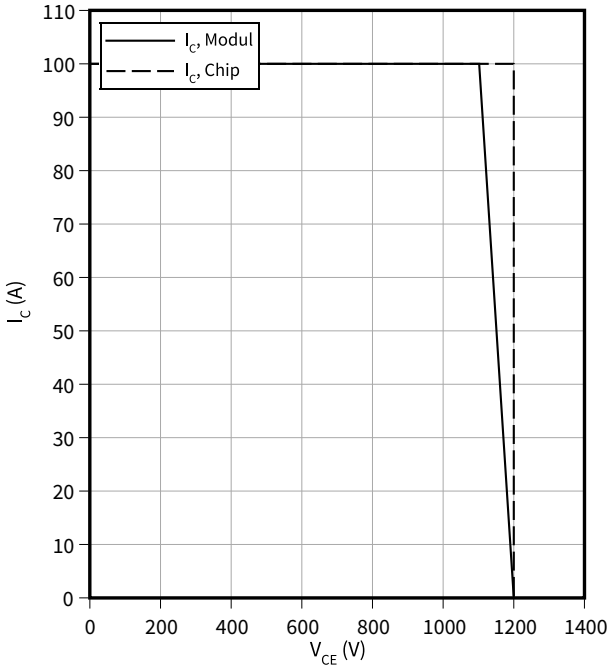
$V_{GE} = \pm 15$ V, $I_C = 50$ A, $V_{CC} = 600$ V, $T_{vj} = 175$ °C



Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich (RBSOA), IGBT, Wechselrichter

$I_C = f(V_{CE})$

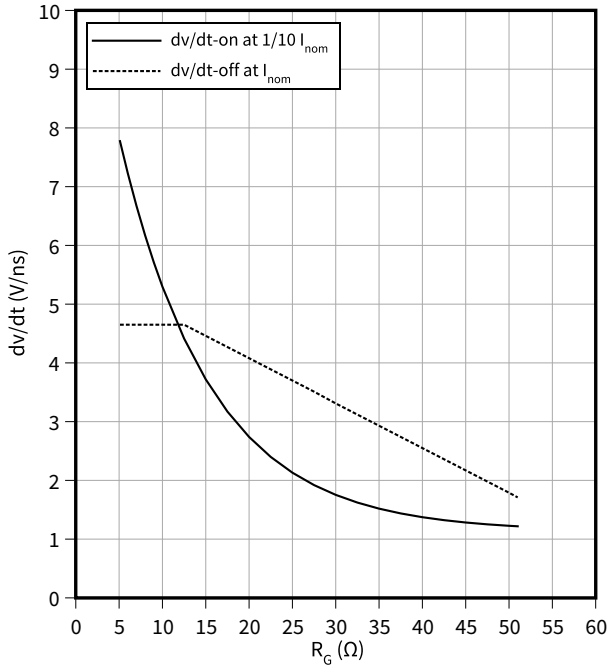
$R_{Goff} = 5.1\ \Omega$, $V_{GE} = \pm 15$ V, $T_{vj} = 175$ °C



Spannungssteilheit (typisch), IGBT, Wechselrichter

$dv/dt = f(R_G)$

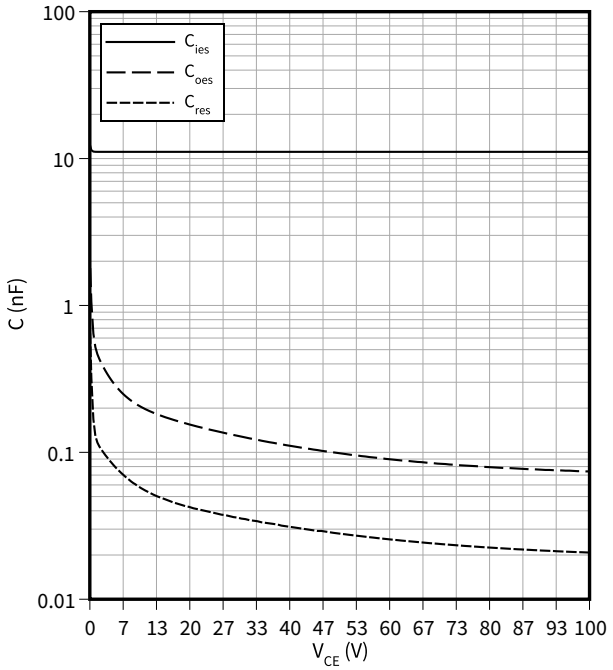
$I_C = 50$ A, $V_{CC} = 600$ V, $V_{GE} = \pm 15$ V, $T_{vj} = 25$ °C



Kapazitäts Charakteristik (typisch), IGBT, Wechselrichter

$C = f(V_{CE})$

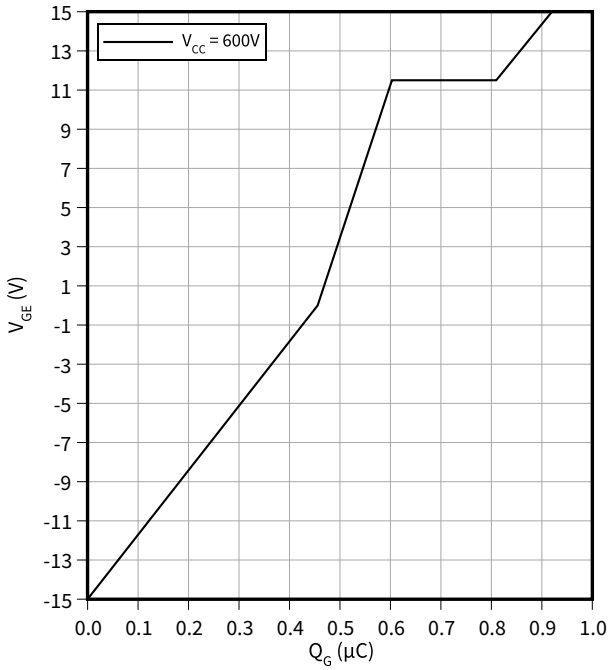
$f = 100$ kHz, $V_{GE} = 0$ V, $T_{vj} = 25$ °C



Gateladungs Charakteristik (typisch), IGBT, Wechselrichter

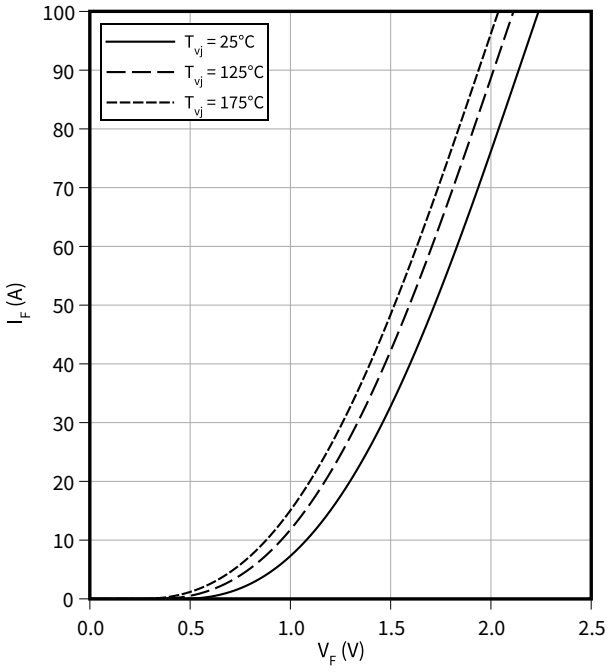
$V_{GE} = f(Q_G)$

$I_C = 50$ A, $T_{vj} = 25$ °C



Durchlasskennlinie (typisch), Diode, Wechselrichter

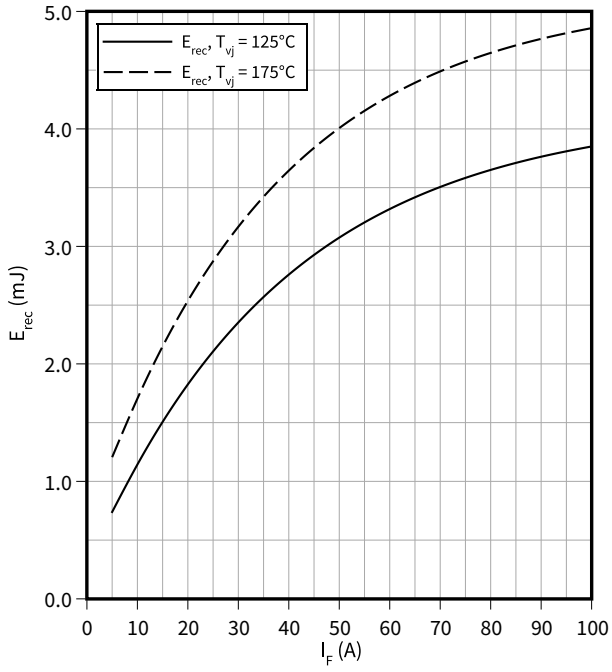
$I_F = f(V_F)$



Schaltverluste (typisch), Diode, Wechselrichter

$E_{rec} = f(I_F)$

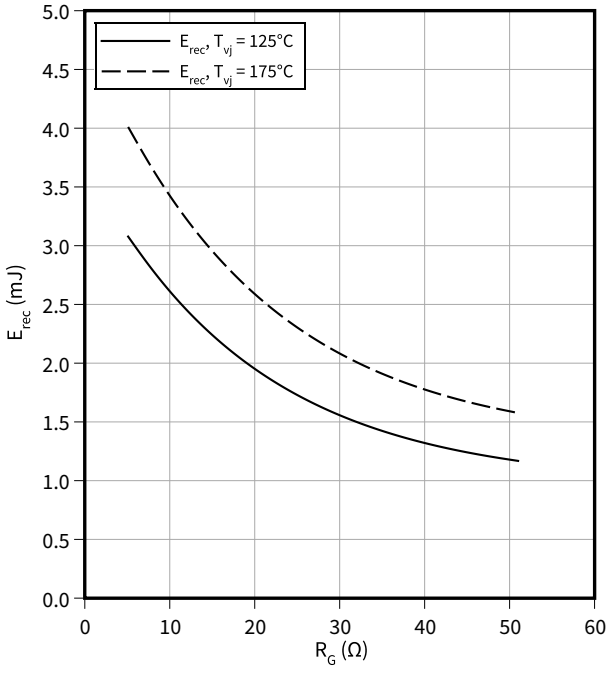
$R_{Gon} = 5.1\ \Omega$, $V_{CC} = 600$ V



Schaltverluste (typisch), Diode, Wechselrichter

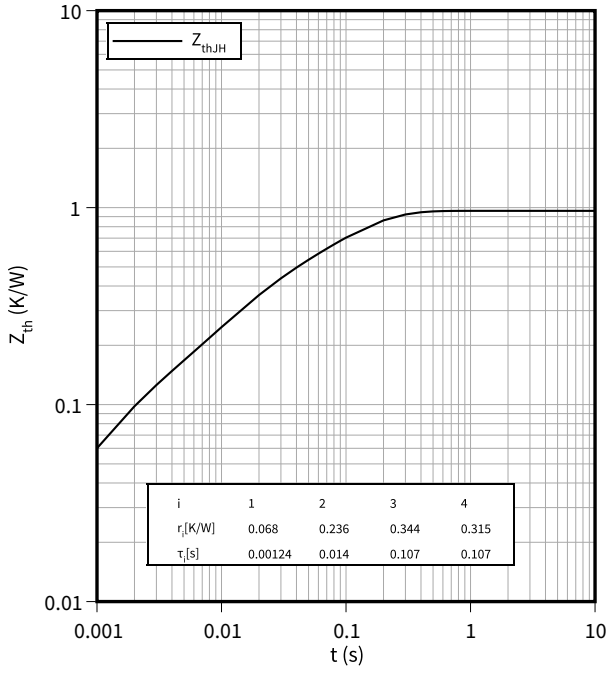
$E_{rec} = f(R_G)$

$I_F = 50$ A, $V_{CC} = 600$ V



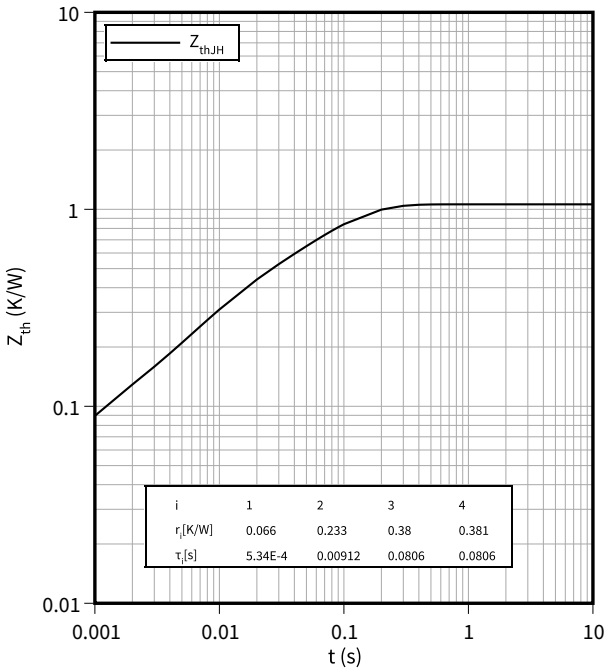
Transienter Wärmewiderstand, Diode, Wechselrichter

$Z_{th} = f(t)$



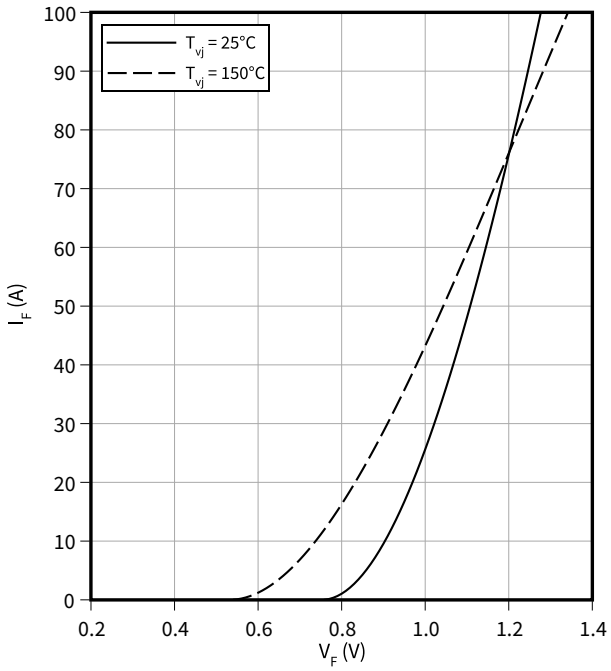
Transienter Wärmewiderstand, Diode, Gleichrichter

$Z_{th} = f(t)$



Durchlasskennlinie (typisch), Diode, Gleichrichter

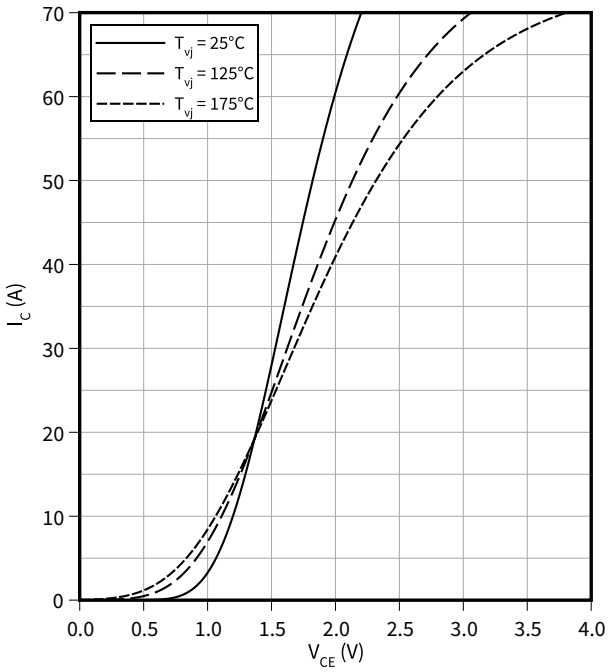
$I_F = f(V_F)$



Ausgangskennlinie (typisch), IGBT, Brems-Chopper

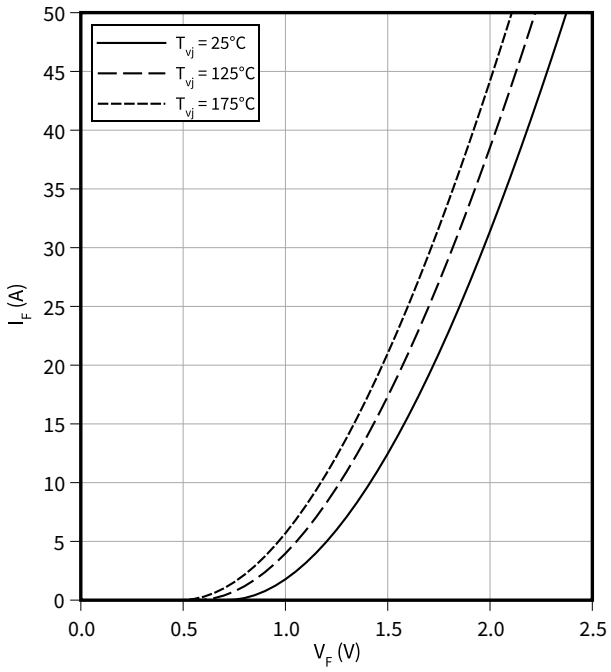
$I_C = f(V_{CE})$

$V_{GE} = 15\ V$



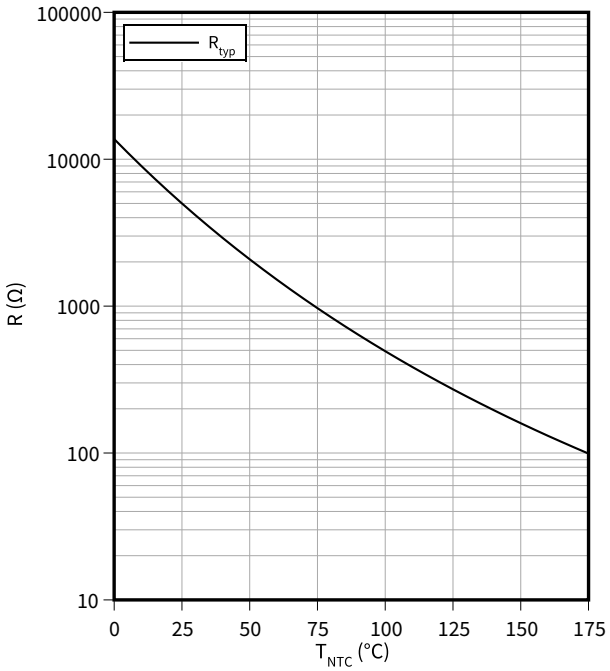
Durchlasskennlinie (typisch), Diode, Brems-Chopper

$I_F = f(V_F)$



Temperaturkennlinie (typisch), NTC-Widerstand

$R = f(T_{NTC})$



9 Schaltplan

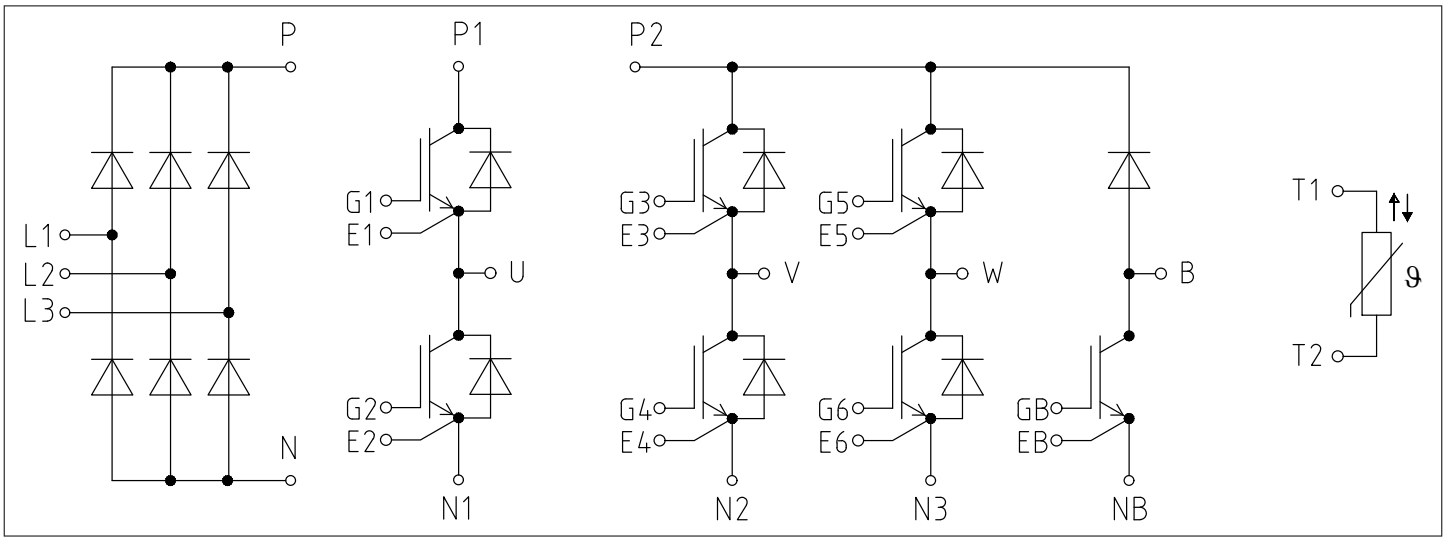


Abbildung 1

10 Gehäuseabmessungen

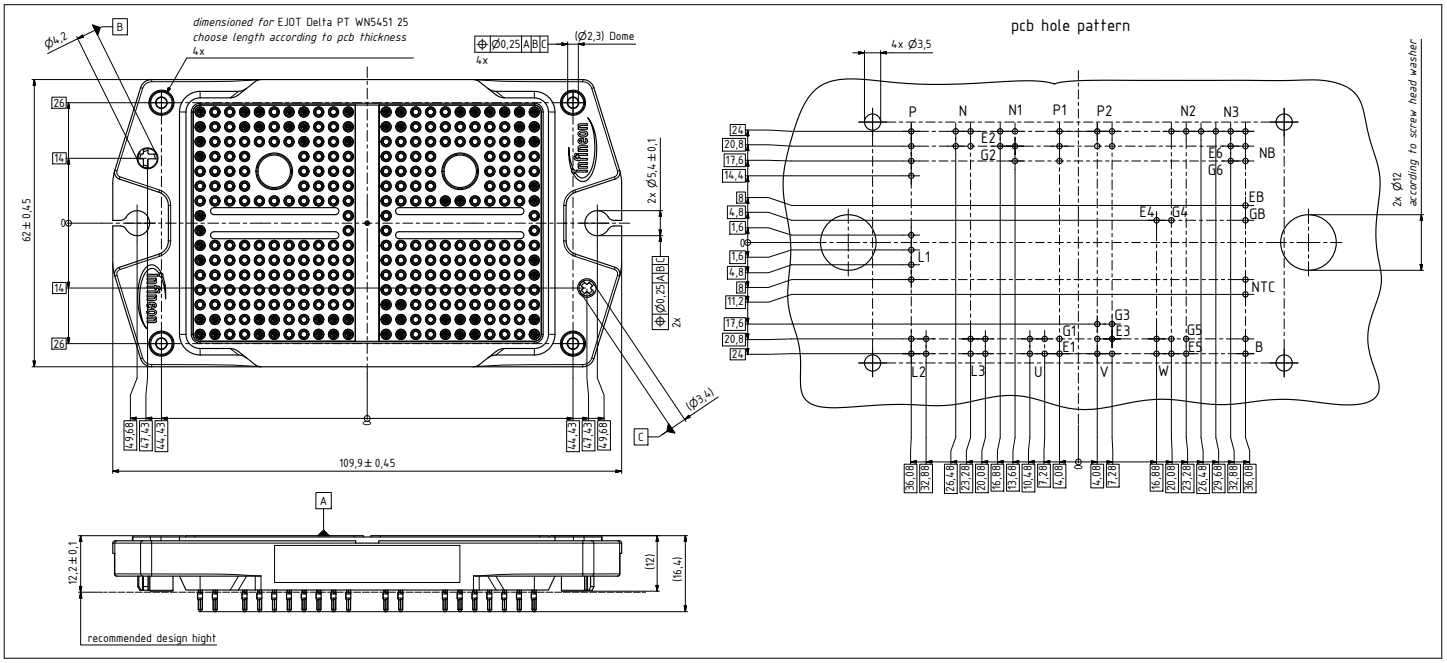


Abbildung 2

11 Modul-Label-Code

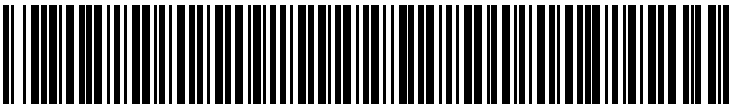
Module label code			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	*Content* Module serial number Module material number Production order number Date code (production year) Date code (production week)	*Digit* 1 – 5 6 - 11 12 - 19 20 – 21 22 – 23	*Example* 71549 142846 55054991 15 30
Example	 7154914284655054991530	 7154914284655054991530	

Abbildung 3

Änderungshistorie

Dokumentenrevision	Freigabedatum	Beschreibung der Änderungen
V1.0	2020-08-20	Target datasheet
n/a	2020-09-01	Datasheet migrated to a new system with a new layout and new revision number schema: target or preliminary datasheet = 0.xy; final datasheet = 1.xy
1.00	2022-09-27	Final datasheet
1.10	2022-12-13	Final datasheet

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2022-12-13

Published by

Infineon Technologies AG

81726 Munich, Germany

© 2022 Infineon Technologies AG

All Rights Reserved.

Do you have a question about any aspect of this document?

Email: erratum@infineon.com

Document reference
IFX-AAY210-003

Wichtiger Hinweis

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keinesfalls Garantien für die Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes ("Beschaffenheitsgarantie") dar.

Für Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben, die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen, ist jegliche Gewährleistung und Haftung von Infineon Technologies ausgeschlossen, einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, die Gewähr dafür, dass kein geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen sämtliche, in diesem Dokument enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für die beabsichtigte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Produktdaten für diese Anwendung obliegt den technischen Fachabteilungen des Kunden.

Warnhinweis

Aufgrund der technischen Anforderungen können Produkte gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte mit dem nächsten Vertriebsbüro von Infineon Technologies in Verbindung.

Sofern Infineon Technologies nicht ausdrücklich in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument zugestimmt hat, dürfen Produkte von Infineon Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in welchen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass ein Fehler des Produktes oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu Personenverletzungen führen.